第十六届核电子学与核探测技术学术年会分会场报告

基于**GEM**预放大的**MicroMegas** 探测器的性能研究

范胜男 核探测与核电子学国家重点实验室 中国科学院高能物理研究所 fansn@ihep.ac.cn





- 1.探测器介绍
- 2.探测器性能研究
 - 2.1 电子学标定
 - 2.2 最佳场强比确定
 - 2.3 增益测量
 - 2.4 ⁵⁵Fe X放射源能谱
 - 2.5 能量分辨率
 - 2.6 上升时间测量
 - 2.7 打火率测量
- 3. 结论







探测器结构示意图

在MicroMegas探测器微结构的基础 上,在微网上方1.4mm处放了一层标准 GEM膜作为预放大。

加了GEM膜预放大的MicroMegas探测器,能获得更高的增益,缓解雪崩区放 大压力,降低探测器的打火率,提高了 子探测器的性能。

雪崩区由Bulk工艺形成的128um高的 绝缘柱阵列支撑金属网形成。绝缘柱直 径200um,周期为2mm,死区不到1%。金 属网采用400目不锈钢编织网,丝径22um, 孔径40um。



- 标准Micromegas--->加GEM膜----->组装 ----->完成 "例科学院为能物程列究所" 2012/9/4

2. 探测器性能研究

2.1 电子学刻度



 $Q = 2.48 \times 10^{-16} CH - 5.88 \times 10^{-15}$



2.2 最佳场强比的确定





- 2.3 ⁵⁵Fe X放射源能谱
- ✓当Ar气层厚度为4mm时,转换效率大约为13%。
- ✓入射粒子进入探测器,与工作气体发生反应,在漂移区产生的原初电子经过了两级放大: 1.GEM和2.MicroMegas。在传输区产生的原初电子则只经过MicroMegas的一级放大。



2012/9/4

效率 η 随 Χ 射线能量与气体层厚度的关系



2.3 ⁵⁵Fe X放射源能谱

✓有两个全能峰和逃逸峰,全能峰位置与逃逸峰位置的比值分别为1.96、1.95。(工作气体为95%Ar+5%ISO)
✓根据两个全能峰的比值,可以求得GEM的放大倍数:





2.4 增益测量

- ✓ 当GEM膜两端电压一定时,增益与微网电压成指数关系;
- ✓ 由于GEM膜的预放大,当微网电压一定时,增益随GEM膜电压差的升高 而升高,增益能达到30000;
- ✓ 通过以步长20V增加GEM的电压,每次增益能至少增加60%;
- ✓ 在相同微网电压下, 该探测器相对于无GEM膜的标准MicroMegas探测器, 增益要高。高多少跟GEM膜的增益有关。



2.5 能量分辨率



● 中国科学院高能物理研究所

2.6 上升时间测量



利用示波器记录前放输出信号的波形,统计3000次,测量信号的上 升时间。GEM膜压差为310V,上升时间随微网电压的变化如图10所示。 电荷灵敏前放输出信号的上升时间约为120ns~200ns。

今日科学院高能物理研究所

2.7 打火率测量

- ✓ ⁵⁵Fe X射线源放射性活度为1mCi;
- ✓ 获取记录时间5小时;
- ✓ 电荷量0.57pC@增益15000; 超2pC定义为打火。
- ✓ 打火率=放电数/光子击中数;
- ✓ 探测器相对于Std Micromegas打火率能降低10-100倍;
- ✓ 影响打火的主要因素是微网的电压。



传输区的影响

传输区分别为1.4mm、3.4mm;

- ✓ 传输区为3.4mm时,GEM电压越大,打火率越低。 传输区越大,增加了横向扩散,打火跟局部电荷密 度有关。
- ✓ 打火来源: (1) 经过GEM+Micromegas两次放大的束团; (2) 经过Micromegas单次放大的束团; (3) 上述两种束团的叠加。
- ✓ (2) (3) 的影响大于束团横向扩散对打火率的影响,实验表明,传输区为3.4mm时,打火率较大。





3 结论

- ✓ 由于GEM的预放大,探测器能达到更高的增益;
- ✓ GEM电压增加20V,探测器的总增益能增加至少60%;
- ✓ 漂移区产生的电子经过GEM和MicroMegas的两级放大;传输区产生的电子只经过MicroMegas的一级放大。
- ✓ 探测器的最佳能量分辨率为21%,且随增益的变化稳定;
- ✓ 信号上升时间大概为120ns-200ns;
- ✓ 由于GEM的预放大,缓解了雪崩区的放大压力,相对于标准的

MicroMegas,打火率降低。

Thank you for your attention!

